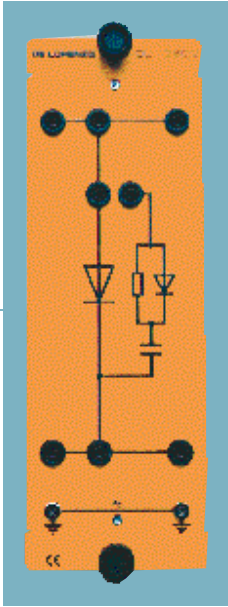
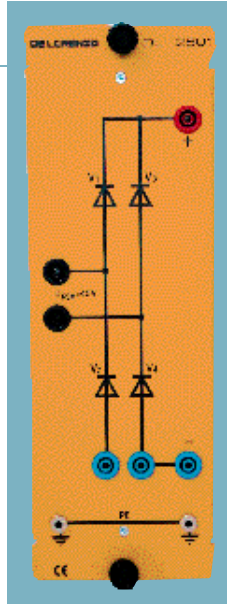


SPECIFICATIONS TECHNIQUES



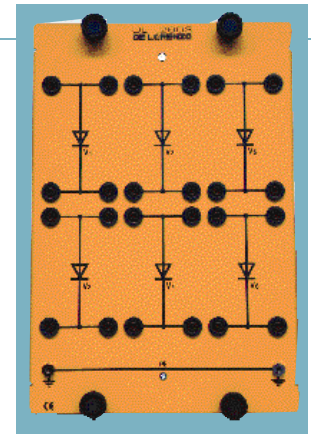
DL 2602
DIODE AU SILICIUM
 Diode au silicium à récupération rapide apte à réaliser les circuits redresseurs; elle peut être employée aussi en diode de libre circulation dans les convertisseurs.

Caractéristiques techniques:
 Courant direct moyenne $I_{FAV} = 12 \text{ A max.}$
 Courant direct de surcharge non répétitive $I_{FSM} = 75 \text{ A}$ ($t_p = 10 \text{ ms}$)
 Tension inverse de crête répétitive $U_{RRM} = 1000 \text{ V}$
 Tension de récupération inverse $t_{tr} = 65 \text{ ns max.}$



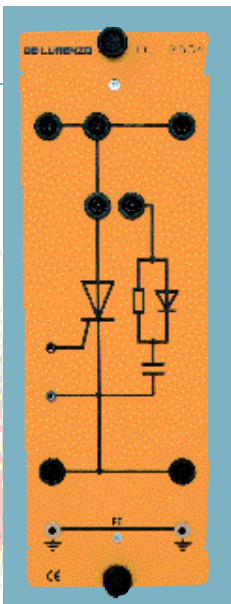
DL 2601
REDRESSEUR AU SELENIUM
 Eléments au sélénium employés pour convertir le courant alternatif dans un courant pulsant en systèmes à basse tension.

Caractéristiques techniques:
 Tension alternative nominale: 30 Vrms
 Tension continue nominale: 24 Vav
 Courant continue nominale: 10 Aav



DL 2603
GROUPE DE DIODES
 Six diodes au silicium à récupération rapide avec réseau RCD de protection aptes à réaliser des circuits redresseurs non contrôlés.

Caractéristiques techniques:
 Courant direct moyenne $I_{FAV} = 12 \text{ A max.}$
 Courant direct de surcharge non répétitive $I_{FSM} = 75 \text{ A}$ ($t_p = 10 \text{ ms}$)
 Tension inverse de crête répétitive $U_{RRM} = 1000 \text{ V}$
 Tension de récupération inverse $t_{tr} = 65 \text{ ns max.}$



DL 2604
SCR
 Redresseur contrôlé au silicium employé dans le contrôle de la puissance, dans les redresseurs contrôlés et dans les inverseurs.

Caractéristiques techniques:
 Courant direct moyenne $I_{TAV} = 7,6 \text{ A max.}$
 Valeur efficace du courant direct $I_{TRMS} = 12 \text{ A}$
 Tension max. inverse répétitive $U_{RRM} = 800 \text{ V}$
 Courant d'amorçage $I_{GT} = 15 \text{ mA max.}$
 Tension d'amorçage $U_{GT} = 1,5 \text{ V max.}$
 $I^2t = 72 \text{ A}^2\text{s}$